- 1. Азьян. Ю. М., Мигулин В. В. «Радиотехника и электроника», 1956, 1, вып. 4,
- 2. Азьян Ю. М., Снигирев О. В., Мрктумов А. С. «Вестн. Моск. ун-та." Сер. III, физ., астрон.», 1972; 13, № 1; 99.
  3. Кугушев А. М., Голубева Н. С. Основы радиоэлектроники. М., 1969. с. 643

и 630. 4. Яворский Б. М., Деллаф А. А. Справочник по физике. С., 1968. с. 460.

Поступила в редакцию 26.1 1976 г.

Кафедра физики колебаний

УДК 535.324

## Ф. А. КОРОЛЕВ, А. Ю. КЛЕМЕНТЬЕВА, С. И. САГИТОВ

# ОПТИЧЕСКИЕ СВОИСТВА ПОКРЫТИИ Na<sub>8</sub>AlFe<sub>6</sub>, PbF<sub>2</sub>, As<sub>2</sub>S<sub>8</sub>, ПОЛУЧЕННЫХ В ВЫСОКОМ И СВЕРХВЫСОКОМ ВАКУУМЕ

В связи с широким применением тонкопленочных интерференционных систем в приборостроении в настоящее время большее внимание уделяется изучению зависимости свойств пленок (оптических, механических и других) от физических условий в про-

цессе их осуществления.

Так, в ряде работ [1—5] изучалась зависимость показателя преломления, плотности, коэффициента упаковки различных пленок от величины вакуума, скорости испарения и состава остаточных газов. Наличие остаточных газов влияет на пленку двояко, внося загрязнения в покрытие и оказывая воздействие на структуру слоя; при этом пленка образуется тем более пористая и рыхлая, чем хуже вакуум [6]. Подобные исследования проводились в дианазоне от 10—8 до 10—6 мм рт. ст.

С развитием техники сверхвысокого вакуума появилась возможность получить пленки в наиболее «чистых условиях», когда остаточные газы ипрают несравнимо меньшую роль в процессах роста и образования структуры тонкой пленки, следовательно, в условиях, способствующих образованию наиболее плотных пленок, сильнее связанных с подложкой. Поскольку с этими явлениями связана более высокая стойкость и стабильность покрытий, то изучение свойств покрытий при переходе к сверхвысокому вакууму представляет определенный интерес. Такое исследование свойств было прове-

дено для фтористого магния MgFe<sub>2</sub> [7].

В нашей работе определялись и сравнивались показатели предомления пленок криолита Na<sub>3</sub>AlF<sub>6</sub>, фтористого свинца PbF<sub>2</sub> и трехсернистого мышьяка As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, полученных в вакууме 10<sup>-5</sup> и 10<sup>-8</sup> мм рт. ст. Чтобы проследить влияние одного фактора — глубины вакуума, мы стремились сохранить равенство всех остальных параметров: скорости испарения, температуры подложек, срстава испаряемых материалов, толщины наносимых слоев. Обычно на практике недооценивается влияще скорости нанесения покрытия, тогда как эта скорость коренным образом влияет на свойства слоев. Так, при высоких скоростях нанесения покрытий >20 A/c неизбежен перегрев источника испарения, в результате чего наблюдается частичный распад молекул вещества [4, 7], загрязнение пленки и ухудшение ее оптических свойств. Скорость нанесения веществ в нашей работе составляла 20 A/c при расстоянии от источника испарения ~250 мм. Толщина слоев составляла 7 λ/4 вблизи λ=9000 A.

Для определения показателя преломления покрытия были использованы соотношения, связывающие коэффициенты пропускания однослойного покрытия в экстремуме с показателями преломления слоя и подложки, приведенные в [8]. Приводимая формула имеет место в участках спектра, где поглощением веществ можно пренебречь:

$$n = \sqrt{\frac{n_0}{T_s}} \cdot (1 + \sqrt{1 - T_s}),$$

по — показатель преломления подложки, а Т. — значение коэффициента пропускания слоя в экстремуме. В расчете учитывались поправки, которые появляются из-за присутствия второй поверхности подложки, на которую нанесены слои, а также вследствие

многократных отражений внутри пластины. Измеренная величина коэффициента пропускания пластины со слоем записывается следующей суммой:

$$T_{\text{H3Mep}} = T_{9}T_{2} + T_{9}T_{2}\alpha + T_{9}T_{2}\alpha^{2} + \dots$$

где  $T_2$  — коэффициент пропускания второй поверхности подложки;  $\alpha$  является произведением коэффициентов отражения первой поверхности со слоем и второй свободной люверхности. Члены суммы, включающие а, составляют поправку. Величина второго слагаемого имеет малое значение в случае криолита Na<sub>8</sub>AlF<sub>6</sub> на флинте, она составляет

Tº/

100

90

80

70

 $4 \times 10^{-5}$  и может не читываться. Вслчае фтористого свинца PbF2 на подложке K-8 поправка составляет ~0,003 и должна быть учтена. Поправка возрастает с увеличением п пленки и для As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> она составляет 0,0110.

Спектральные кривые пропускания веацеств в близкой инфракрасной области, по которым определялись показатели преломления веществ, показаны на рис. 1, а. В участке спектра от 0,6 до 1,6 мкм криолит имеет ряд соответствующих  $nh = (2k+1)\lambda/4$ , а PbF<sub>2</sub> и As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> имеют ряд миянимумов при nh = (2k+1)λ/4. Внизу на рис. 1,δприведены кривые дисперсии показателей препоказателей преломления, относящихся к пленке, нанесенной в сверхвысоком вакууме). Точность определения показателей преломления

дит к выводу, что покрытия, полученные как

60 50 ломления веществ (точками отмечены значения 40 0.6 составляла 0,005. Рассмотрение полученных данных привов высоком, так и сверхвысоком вакууме, хаа: спектральные кривые пропускания однослойных покрытий  $Na_3AlF_6$ ,  $PbF_2$  и  $As_2S_3$ . Оптическая толщина слоев  $\sim 7\lambda_0/4$ ,  $\lambda_0 = 9000$ Å, вакуум 10-8 мм рт. ст. б: кривые дисперсии и к в теле преломл ния Na<sub>4</sub>AlF<sub>4</sub>. Рыб. и 0,6 преломл ния Na<sub>3</sub>AlF<sub>6</sub>, PbF<sub>2</sub> и A, MKM  $As_2S_3$ Показатели преломления образцов. В случае фтористого

рактеризуются высокими значениями коэффициентов преломления, что обусловлено значительной скоростью испарения материалов. веществ свинца близки к вначениям п для массивных близкой изменялся. преломления инфракрасной области показатель В 1,71 - 1,74(сравни показателем преломления составляя величину c массивного образца  $n_D = 1,76$ ). При переходе к сверхвысокому вакууму нам не удалось обнаружить существенного роста и для РьГ2, очевидно, по той причине, что это вещество в условиях более илэкого вакуума образует достаточно плотные слои. В случае криолита эффект перехода к более высокому вакууму был значителен. Показатель преломления слоя возрос на 0,02, достигая величины 1,36—1,375. Этот результат согласуется с более ранними работами, выполненными с криолитом в вакууме от 10-4 до 10-6 мм рт. ст., показавшими, что с улучшением вакуума показатель преломления возрастает от 1,32 до 1,36. Известная гигроскопичность криолитовых пленок [9] должна приводить к преимущественному росту n пленок, полученных в более низком вакууме. Указанное явление, возможно, несколько снизило эффект увеличения n, поскольку измерения проводились на 2—3-й день после изготовления покрытий. Измерения непо-

точно. случае трехсернистого мышьяка As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, часто применяемого инфратехнике [10], показатели преломления пленок составляют чину от 2,35 до 2,45 чину от 2,35 до 2,45 (см. рис. 1,  $\delta$ ), что несколько ниже величины для массивного образца (от 2,44 до 2,49). Авторы полагают, что это связано с тем, что образцы покрытий  $As_2S_3$  были получены в более низком вакууме, а именно: в начале про-10-8 и понижался затем до значения цесса испарения вакуум составлял -5×10<sup>-7</sup> мм рт. ст.

средственно после изготовления позволят обнаружить в дальнейшем эффект более

Переход к сверхвысокому вакууму, как показывают результаты работы, ведет к росту показателя преломления пленки, различному для разных веществ. Этот эффект значителен и его необходимо учитывать в практическом осуществлении многослойных

систем так же, как влияние скорости нанесения пленки и температуры подложки. Получение наиболее плотных «чистых» слоев с максимально высоким коэффициентом преломления, упаковки и другими параметрами обусловлено несколькими факторами: глубоким вакуумом, скоростью ванесения и температурой подложки.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Bourg M., Philip R. «Le Vide», 1964, 227, 112.
2. Pulker H. K., Zamminer C. H. «Thin Solid films.», 1970, 5, 421.
3. Honcia G., Krebs K. «Z fur. Phys.», 1959, 156, 117.
4. Heitmann W., Ritter E. «Appl. Optics», 1968, 7, N 2, 307.
5. Heitmann W. «Thin Solid films», 1970, 5, N 1, 61.
6. Dell H. A. «Proc. Phys. Soc. sec.», 1949, 1862, N 350B, 6.

7. Настап D. «Optica Acta», 1970, 17, 659. 8. Розенберг Г. В. Оптика тонкослойных покрытий. М., 1958, с. 121. 9. Pulker H. K., Young E. «Thin solid films.», 1969, 4, N 3, 219.

10. Young P. A. «Thin solid films.», 1970, 6, N 6, 423.

Поступила в редакцию 1.11 1974 г.

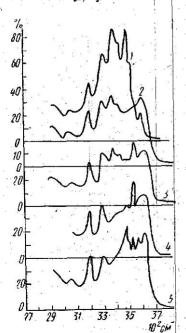
Кафедра оптики

УДК 669-409:539.16.04

### 🗇 В. Г. ЗУБОВ. Л. П. ОСИПОВА, Н. Д. КУНДИКОВА

## ОТЖИГ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В КВАРЦЕ. ОБЛУЧЕННОМ БЫСТРЫМИ НЕИТРОНАМИ

В инфракрасных спектрах поглощения съварца в области 3000 см<sup>-1</sup> проявляются валентные колебания гидроксильных групп, различным образом расположенных в кристаллической решетке. Ион водорода главным образом связан с кислородом, принадлежащим «дефектному» тетраэдру, в котором Si<sup>†\*</sup> изоморфно замещен на Al<sup>+3</sup>. При этом образуется (Al(OH/Me) дефект [1]. Кислород кроме иона водорода может присоединить и ион щелочного металла [1—3]. В таком случае образуется Al(OH/Me) дефект [1]. От типа примеси зависит частота и интенсивность соответствующих полос. При увеличении атомного веса примеси частота валентных колебаний гидроксильных групп увеличивается [2, 4].



При облучении кварца ионизирующей радиацией и быстрыми нейтронами наблюдается изменение спектров поглощения [1, 4-7]. Основными причинами чувствительности спектров поглощения к облучению является радиационно-стимулированное движение примеси ионов щелочных металлов [1, 8] и аморфизация кристаллической матрицы [4, 7]. При нагревании облученных кристаллов до температуры 500° C [4] 900° C [6] наблюдается восстановление спектров, измененных при облучении. Поскольку при увеличении температуры увеличивается скорость диффузии примесных ионов, процессы, происходящие при отжиге, так же должны быть связаны с движением примеси. В литературе, как правило, приводится лишь температура, при которой происходит полное восстановление интенсивности и структуры спектра поглощения в области 3000 см-1 [1, 4, 6] и не затрагивается вопрос об изменении спектра на промежуточных этапах.

В настоящей работе изучается влияние отжига при температуре 250, 300 и 400°C на спектры поглощения в области 3000 см-1 кварца, облученного интегральным потоком быстрых нейтронов  $4 \times 10^{18}$  н/см<sup>2</sup>.

Отжиг проводился по следующей методике. Образец со скоростью 0,5-2° С в минуту нагревался до температуры отжига, при этой температуре образец выдерживался 3-5 ч и вновы